

InGaAs фотодетекторный чип 1740 нм, 1000 мкм — техническое описание

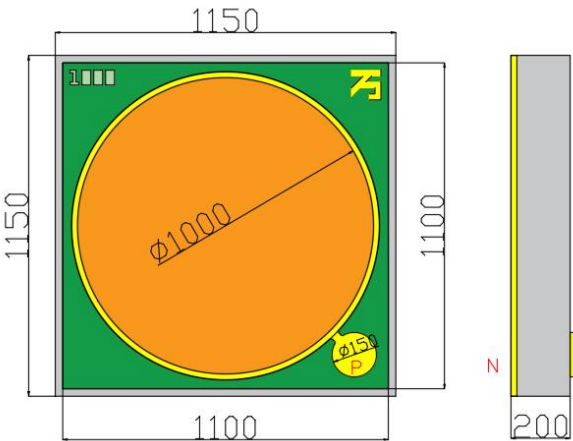
P/N : WIR3-1000

Особенности

Высокая чувствительность; низкий темновой ток;
спектральная чувствительность 900–1740 нм

Структура

InGaAs/InP PIN-чип. Р-электрод (анод): золото.
N-электрод (катод): золото.



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	995	1000	1005	мкм
Ширина чипа	1130	1150	1170	мкм
Длина чипа	1130	1150	1170	мкм
Высота чипа	180	200	220	мкм
Размер контактной площадки	140	150	160	мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Темновой ток	Id	Vr=-5V	-	0.5	2.5	нА
Емкость	Cp	Vr=-5V	-	55	65	пФ
Чувствительность	R	@1654 nm	0.9	1	-	А/Вт
Рабочий диапазон длин волн	λ		900	1650	1740	нм

Примечание: ESD (HBM) > 800 В

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Рабочая температура	от -40 °C до +85 °C
Температура хранения	от -55 °C до +125 °C
Прямой ток	10 мА